

Liste des tableaux :

Tab.3.1 : Représente les valeurs du V_{co} , J_{sc} , FF et du rendement (en absence des défauts).

Tab.3.2 : Effet d'un seul défaut, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule a-si (h).

Tab.3.3 : Effet d'un seul défaut, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule a-si(h).

Tab.3.4 : Représente les valeurs du V_{co} , J_{sc} , FF et du rendement (en absence des défauts).

Tab.3.5 : Effet d'un seul défaut, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CIGS.

Tab.3.5 : Effet d'un seul défaut, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CIGS.

Tab.3.7 : Représente les valeurs du V_{co} , J_{sc} , FF et du rendement (en absence des défauts).

Tab.3.8 : Effet d'un seul défaut, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CdTe.

Tab.3.9 : Effet d'un seul défaut, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CdTe.

Tab.3.10 : Effet de deux défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CdTe.

Tab.3.11 : Effet de deux défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CIGS.

Tab.3.12 : Effet de deux défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CIGS.

Tab.3.13 : Effet de deux défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule a-si (h).

Tab.3.14 : Effet de trois défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CIGS.

Tab.3.15 : Effet de trois défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CIGS.

Tab.3.16 : Effet de trois défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CdTe.

Tab.3.17 : Effet de trois défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CdTe.

Tab.3.18 : Effet de trois défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule a-si(h).

Tab.3.19 : Effet de trois défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule a-si(h).

Tab.3.20 : Effet de quatre défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule a-si(h).

Tab.3.21 : Effet de quatre défaut, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CdTe.

Tab.3.22 : Effet de quatre défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CdTe.

Tab.3.23 : Effet de quatre défauts, uniformément distribué, sur la caractéristique de la cellule CIGS.

Tab.3.24 : Effet de quatre défauts, avec une distribution gaussienne de l'énergie, sur les caractéristiques de la cellule CIGS.